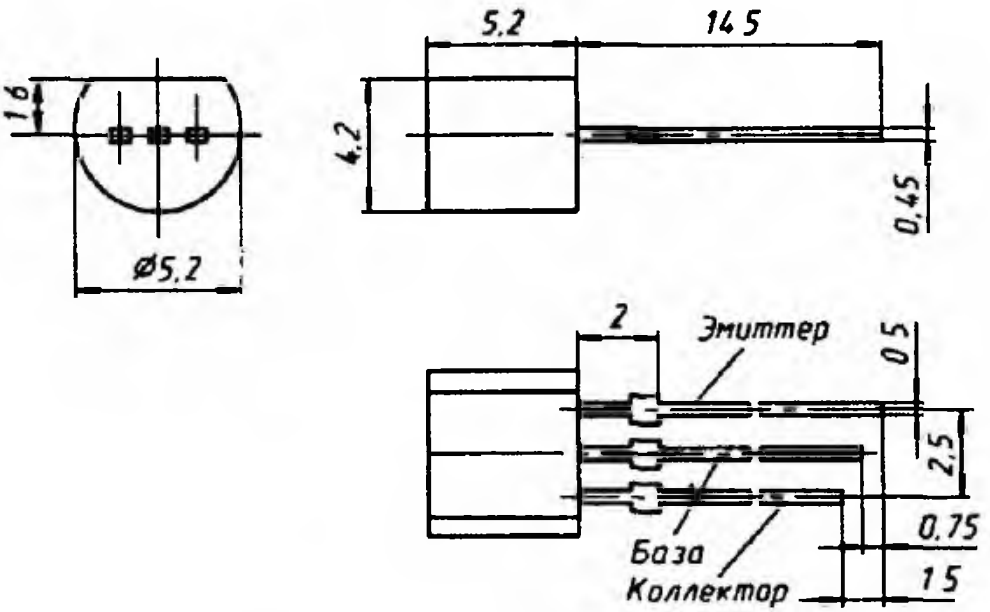
КТ352А, КТ352Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится условная маркировка двумя цветными точками: КТ352А — зеленой и розовой, КТ352Б — зеленой и желтой.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Изготовитель — завод полупроводниковых приборов, г. Рига.

КТ352(А, Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}$ = 1 В, $I_Э$ = 200 мА:

T = +25 °С:	
КТ352А	25...65*...120
КТ352Б	70...115*...300
T = −40 °С, не менее	0,3 значения при T = +25 °С
T = +85 °С	От 0,9 до 2 значений при T = +25 °С

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КБ}$ = 5 В, $I_Э$ = 10 мА, не менее	200 МГц
типовое значение	450* МГц

ООО компания "Электроника и Связь"
www.eandc.ru +7(473) 277-14-34

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_К$ = 200 мА, $I_Б$ = 20 мА для КТ352А, $I_Б$ = 3 мА для КТ352Б, не более	0,6 В
типовое значение	0,37* В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_К$ = 200 мА, $I_Б$ = 20 мА для КТ352А, $I_Б$ = 3 мА для КТ352Б, не более	1,1 В
типовое значение	0,81* В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ}$ = 10 В, не более:	
T = +25 °С	1 мкА
T = +85 °С	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ}$ = 4 В, не более	10 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ}$ = 5 В, не более	15 пФ
типовое значение	9,5* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ}$ = 1 В, не более	30 пФ
типовое значение	20* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	20 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} \leqslant$ 10 кОм	15 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	5 В
Импульсный ток коллектора при $t_и \leqslant$ 1 мкс, $Q \geqslant$ 10	200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора[1]:	
при $T \leqslant$ +30 °С	300 мВт
при T = +85 °С	162,5 мВт
Тепловое сопротивление переход—среда	0,4 °С/мВт
Температура p-n перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	−40...+85 °С

[1] В диапазоне температур +30...+85 °С допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно.

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 5 мм при температуре не выше +250 °С и длительности не более 10 с. Температура корпуса при пайке не должна превышать +150 °С.

ООО компания "Электроника и Связь"
www.eandc.ru +7(473) 277-14-34